

关键指标

- 射频&本振频率：4~8GHz
- 中频频率：DC~3.5GHz
- 本振功率：13dBm
- 变频损耗：8dB
- LO/RF 隔离度：37dB
- 芯片尺寸：1.45mm×0.8mm

产品简介

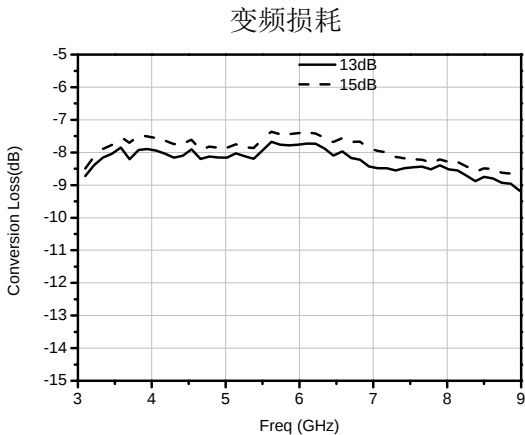
HG124H2/HG124H2(M)是一对镜像无源双平衡混频器芯片，射频和本振频率为 4~8GHz，中频频率为 DC~3.5GHz，变频损耗为 8dB。

电性能（TA=25℃）

| 指标            | 最小值    | 典型值 | 最大值 |
|---------------|--------|-----|-----|
| RF&LO 频率(GHz) | 4~8    |     |     |
| IF 频率(GHz)    | DC~3.5 |     |     |
| 变频损耗(dB)      | —      | 8   | —   |
| LO~RF 隔离度(dB) | —      | 37  | —   |
| LO~IF 隔离度(dB) | —      | 35  | —   |
| RF~IF 隔离度(dB) | —      | 20  | —   |

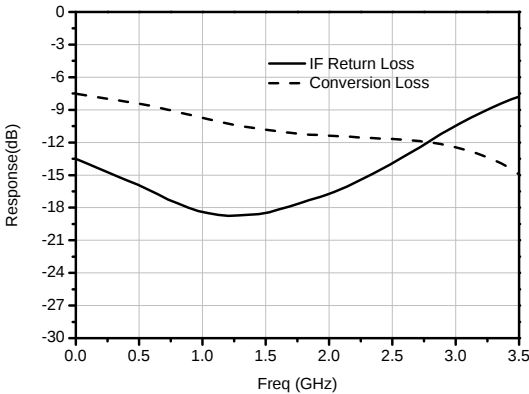
典型测试曲线

未注明情况下 IF=100MHz

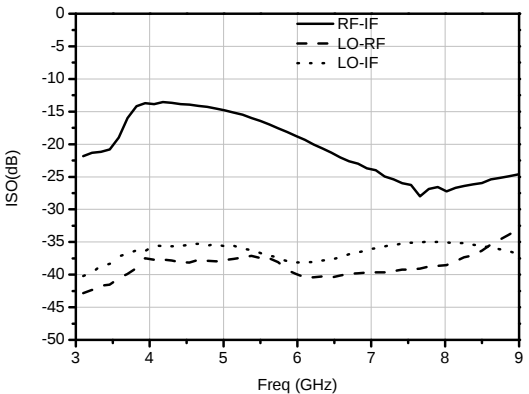


中频带宽

- IF : 0.01-4GHz
- RF: 6GHz
- LO: 6GHz-10GHz



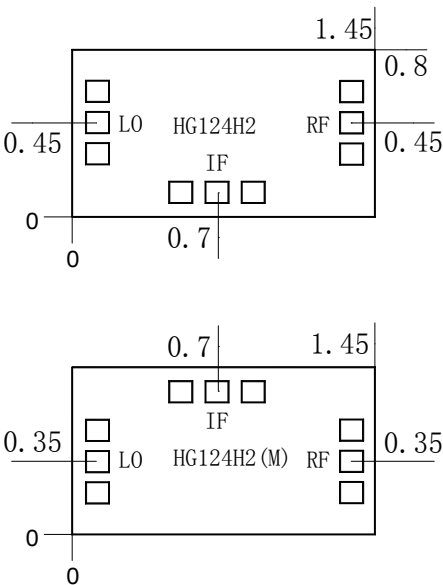
隔离度



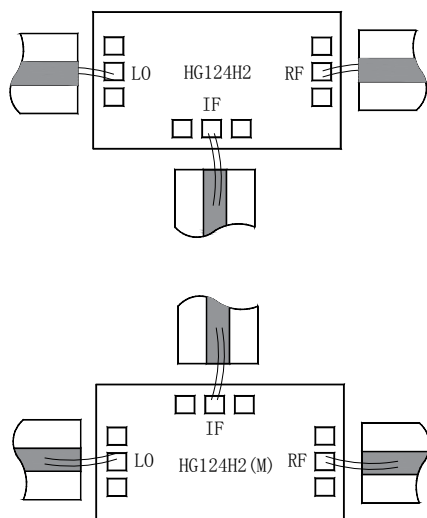
绝对额定最大值

|        |           |
|--------|-----------|
| 最大输入功率 | +20dBm    |
| 工作温度   | -55℃~125℃ |
| 存储温度   | -65℃~150℃ |

外形和端口尺寸（mm）



### 推荐装配图



### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。